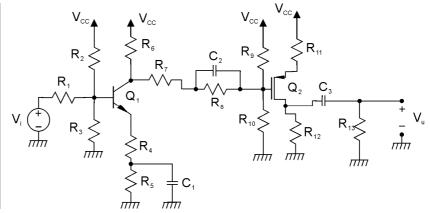
ELETTRONICA DIGITALE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 28 gennaio 2016

Esercizio A

$R_1 = 15.4 \text{ k}\Omega$	$R_{10} = 8 k\Omega$
$R_2 = 10 \text{ k}\Omega$	$R_{11} = 3.5 \text{ k}\Omega$
$R_4 = 50 \Omega$	$R_{12} = 3.5 \text{ k}\Omega$
$R_5 = 3450 \Omega$	$R_{13} = 10 \text{ k}\Omega$
$R_6 = 2400 \Omega$	$C_1 = 100 \text{ nF}$
$R_7 = 200 \Omega$	$C_2 = 22 \text{ nF}$
$R_8 = 7800 \Omega$	C ₃ = 1.5 nF
$R_9 = 20 \text{ k}\Omega$	$V_{CC} = 18 \text{ V}$



 Q_1 è un transistore BJT BC109B resistivo con $h_{re} = h_{oe} = 0$; Q_2 è un transistore MOS a canale p resistivo, con la corrente di drain in saturazione data da $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$ con k = 0.5 mA/V² e $V_T = -1$ V;. Con riferimento al circuito in figura:

- 1) Calcolare il valore della resistenza R_3 in modo che, in condizioni di riposo, la tensione sul source di Q_2 sia 11 V. Determinare, inoltre, il punto di riposo dei due transistori e verificare la saturazione di Q_2 . (R: $R_3 = 14720 \Omega$)
- 2) Determinare l'espressione e il valore di V_U/V_i alle frequenze per le quali C_1 , C_2 , e C_3 possono essere considerati dei corto circuiti. (R: $V_U/V_i = 3.7$)
- 3) (<u>Solo per 12 CFU</u>) Determinare la funzione di trasferimento V_U/V_i e tracciarne il diagramma di Bode quotato asintotico del modulo. (R: $f_{z1} = 461.3$ Hz; $f_{p1} = 20302.8$ Hz; $f_{z2} = 927.5$ Hz; $f_{p2} = 1797.58$ Hz; $f_{z3} = 0$ Hz; $f_{p3} = 7859.5$ Hz;)

Esercizio B

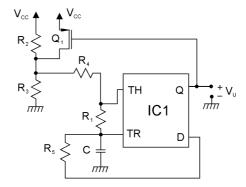
Progettare una porta logica in tecnologia CMOS, utilizzando la tecnica della pull-up network e della pull-down network, che implementi la funzione logica:

$$Y = \overline{AE}(\overline{B}C + \overline{D}) + A\overline{B}C + \overline{D}\overline{C}$$

Determinare il numero dei transistori necessari e disegnarne lo schema completo. Dimensionare inoltre il rapporto (W/L) di tutti i transistori, assumendo, per l'inverter di base, W/L pari a 2 per il MOS a canale n e pari a 5 per quello a canale p. Si specifichino i dettagli della procedura di dimensionamento dei transistori.

Esercizio C

$R_1 = 1200 \ \Omega$	$R_5 = 200 \Omega$
$R_2 = 1 \text{ k}\Omega$	C = 47 nF
$R_3 = 4 \text{ k}\Omega$	$V_{CC} = 6 V$
$R_4 = 200 \Omega$	



Il circuito IC₁ è un NE555 alimentato a $V_{CC} = 6V$, Q_1 ha una $R_{on} = 0$ e $V_T = -1V$. Determinare la frequenza del segnale di uscita del multivibratore in figura. (R: f = 18872 Hz)

1) Det.
$$R_3$$
 per $V_5 = 18V$

$$T_{11} = \frac{V(c - V_5)}{R_{12}} = 2mA = I_5$$

$$V_{65} = V_7 - \sqrt{I_5} = -1 - 2 = -3V$$

$$V_6 = V_{65} + V_5 = -3 + 11 = 8V$$

$$V_{c} = V_{c} + (R_{1} + R_{8}) I_{7} = 12 V$$

$$\overline{L}_6 = \frac{Vcc - Vc}{R_6} = 2.5 \text{ m} \text{ A}$$

$$I_C = I_6 - I_7 = 2mA = I_E$$

$$I_2 = \frac{V_{cc} - V_B}{R_2} = 1.03 \text{ m} \text{ A}$$

$$T_{L} = \frac{V_{B}}{R_{L}} = 0.5 \text{ m } \Delta$$

$$I_3 = I_2 - I_1 - I_3 = 5.231 \times 10^{-6} A$$

$$C_2 = 22 \text{ nF}$$
 $C_3 = 1.5 \text{ nF}$

$$K = 0.5 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$$

$$Q_2 = \begin{cases} \overline{A}_8 = 2mV \\ V_{55} = -4V \end{cases}$$

$$V_{65} = -3V$$

$$Q_m = 2K[V_{65}, V_7]$$

$$= 2 \times 10^{-3} \frac{A}{V}$$

$$Q_{L} = \begin{cases} I_{c} = 2mA \\ V_{c} = 5V \\ h_{e} = 290 \\ h_{e} = 30e \\ h.e = 4800 R \end{cases}$$

R2 R8 G

R2 IIR3 hie who is fre C2 freglikio

R11 FR11

R2 IIR3 FR11

R2 IIR3 FR11

R3 FR11

R3 FR11 Oi Reliks is the wheeis Rankelliks Amplifications a centre banda Vu = (- gm Vgs) (R1211R13) Us= Ris gm Vgs Vgs = Vg - g m R11 Vgs = Vg I + g m R11 Vg = (RgIIR10) (-hfeib) R6
R1 R2+ RallR10 Viz RellR3 = (RellR3) is + hie is + R4 (hpers) is Reserved in the Reliks State Republication of the Reliks State Sta 0.2788 4.142×10-5 $A_{CB} = \left[g_{m} \left(R_{12} || R_{13} \right) \right] \frac{\rho}{1 + q_{m} R_{14}} \left(R_{g} || R_{10} \right) \left(h \rho_{e} \right) \frac{R_{6}}{R_{6} + R_{7} + R_{3}} \frac{1}{|| R_{10} ||} \frac{1}{R_{2} + R_{2} || R_{3}} \cdot \frac{1}{hi_{e} + \left(R_{1} || R_{1} || R_{3} \right) + R_{4} || R_{14} || R_{1$ = + 3.7042 1 Acoldo = 13.374 POLI E ZERI fr = = = 468.32 Hz for = 1 = 20302.26 Hz

Rus = RS 11 [R4+ hie+ Rs 11R211R3] = 78.39 JZ

N. MOSFET = 14

$$f_{23} = \phi$$

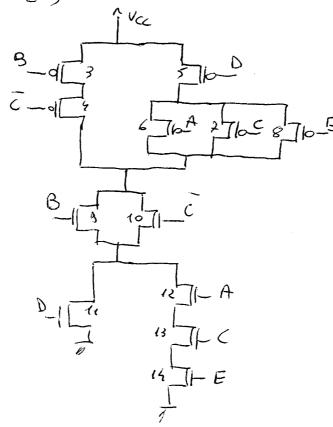
$$f_{P3} = \frac{?}{2\pi c_3(R_{12}+R_{13})} = 7859.5 \text{ Hz}$$

$$Y = A\overline{E}(BC + \overline{D}) + ABC + \overline{DC} =$$

$$= (\overline{A} + \overline{E})(BC + \overline{D}) + ABC + \overline{DC} =$$

$$=\overline{B}C(\overline{A}+\overline{E}+A)+\overline{D}(\overline{A}+\overline{C}+\overline{E})=$$

$$= \overline{B}C + \overline{D}(\overline{A} + \overline{C} + \overline{E})$$



$$\frac{1}{2}\left(\frac{w}{2}\right)_{Q_{1}} = \rho = 5$$

$$\left(\frac{w}{2}\right)_{Q_{2}} = n = 2$$

$$\left(\frac{w}{2}\right)_{Q_{2}} = n = 2$$

P.U.N.

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x} = \frac{1}{p} \Rightarrow x = 2p = 10$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{3,4,5,6,7,8} = 2\rho = 10$$

PDN

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} = \frac{1}{x} = 0 \quad x = 4x = 8$$

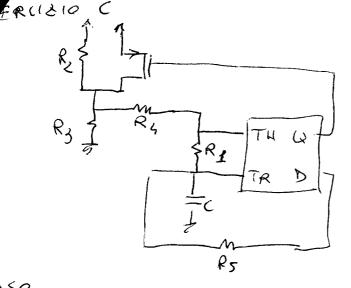
$$2^{e}$$
 of zione $2g - 4n = 3 + \frac{1}{4n} = \frac{1}{n} = 3 \times = \frac{4}{3}n = \frac{8}{3}$

$$\left(\frac{\mathcal{W}}{\mathcal{L}}\right)_{11} = \frac{8}{3} \quad \left(\frac{\mathcal{W}}{\mathcal{L}}\right)_{10} = 4n = 8$$

da 21 opéine no è od oser MINIMA qui la

shitine Gracette E:

$$\left(\frac{\mathcal{W}}{\mathcal{L}}\right)_{i0} = \left(\frac{\mathcal{W}}{\mathcal{L}}\right)_{i1} = 2n = 4$$



$$R_1 = 1200 \Omega$$

$$R_2 = 1 k \Omega$$

$$R_3 = 4 k \Omega$$

$$R_4 = 200 \Omega$$

$$R_5 = 200 \Omega$$

$$C = 47 n F$$

$$Vcc = 6 V$$

10 caso

$$\begin{cases} R_{2} & R_{4} \\ R_{2} & R_{4} \\ R_{3} & R_{1} \\ R_{3} & R_{1} \\ R_{2} & R_{3} \\ R_{2} & R_{3} \\ R_{2} & R_{3} \\ R_{3} & R_{4} \\ R_{4} & R_{5} \\ R_{5} & R_{4} \\ R_{5} & R_{5} \\ R_{5} & R_$$

$$\frac{V_{R} = V_{CC} \frac{R_3}{R_1 + R_2} = 4.8 V}{= 4.8 V}$$

$$R_{3} = \frac{1}{2} V_{con} = \frac{$$